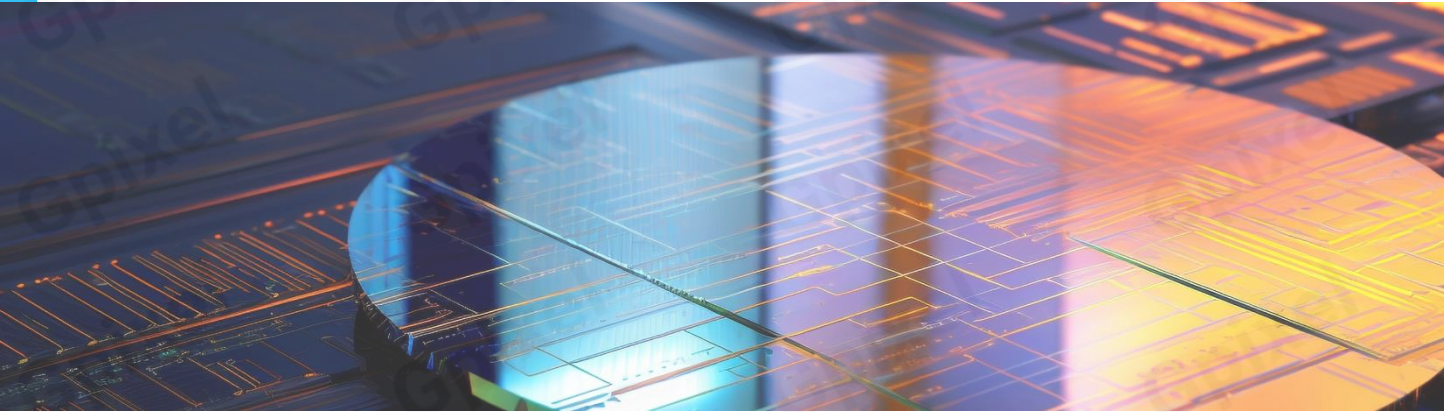
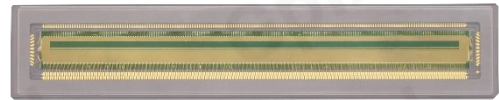


GLT5016BSI 产品彩页



16K背照式CMOS TDI图像传感器

GLT5016BSI 是一款背照式(BSI)、时延积分 (TDI)、电荷域 CMOS 图像传感器，水平方向有效分辨率为16416，像素尺寸为5 μm ，最高满阱15 ke⁻，具有优异的 anti-blooming能力以及大于0.99996的电荷转移效率 (CTE)，最高级数支持256级，最高行频可达500k Hz，在最高行频情况下功耗小于6.4 W，为确保高可靠性和良好的散热性能，其采用415引脚的 μ PGA陶瓷封装。GLT5016BSI具备高分辨率、高灵敏度、高帧频、低功耗等优异性能，同时片上集成了时序控制模块和电源管理模块，支持通道合并、可选扫描方向等功能，为基因测序、半导体检测、屏幕检测等应用带来更加准确、简单、高效的解决方案。GLT5016BSI支持两种版本：一种是UV版本（可拆玻璃盖），着重提升300 nm以下的量子效率，在266 nm的量子效率>70%；另外一种为VIS版本（不可拆玻璃盖），着重优化可见光谱段量子效率，410 nm – 660 nm区间内，量子效率均>80%。



产品特性

- 双感光谱段
- 像素尺寸: 5 μm
- 背照式、TDI
- 高灵敏度
- 双谱段HDR
- 峰值量子效率: 92% @ 436 nm

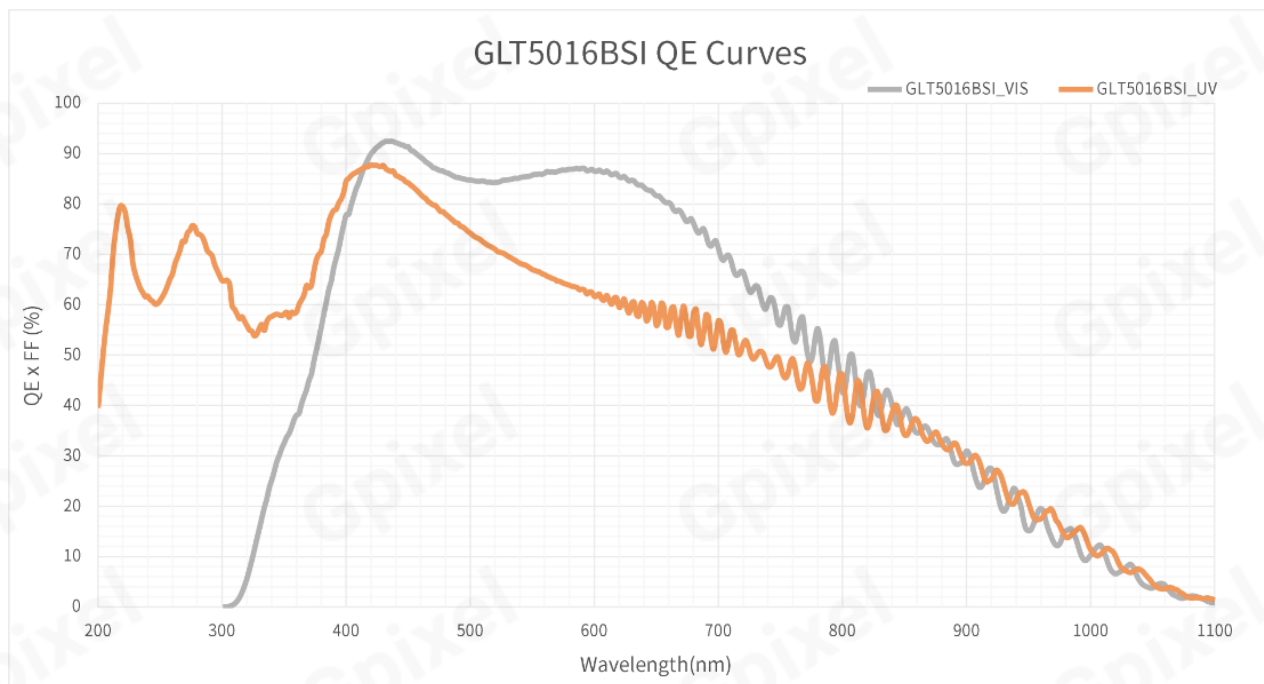
应用领域

- 平板显示器检测
- PCB检测
- 晶圆检测
- 荧光显微成像
- 医疗

产品指标

像素尺寸	5 μm x 5 μm	色彩	黑白
分辨率	P1: 16416 pixels x 256 stages P2: 16416 pixels x 32 stages	感光面长度	82.08 mm
满阱容量	15 ke ⁻	读出噪声	7.7 e ⁻
动态范围	65.8 dB	暗电流	1.0 ke ⁻ /pixel/s @ 16.5°C
量子效率	UV版本 70.7% @ 266 nm、87.8% @ 420 nm VIS版本 92.4% @ 436 nm、87.0% @ 590 nm	ADC位数	12 bit
电荷转移效率 (CTE)	≥ 0.99996	可选TDI级数	P1: 256/252/224/192/128/64/32/4 P2: 32/30/28/24/16/8/4/2
Anti-blooming	x50	最高行频	500k Hz
输出接口	108对 Sub-LVDS	功耗	6.2 W
最大数据率	103.68 Gbps	通道合并	108/96/72/48/36/24/12
供电电压	3.3 V (模拟)、1.65 V (ADC) 1.6 V (数字)	封装形式	μPGA 415 pins (98.08 mm x 19.00 mm)

QE曲线



联系方式

长光辰芯 (总部)

地址: 吉林省长春市经济技术开发区自由大路7691号, 光电信息产业园一期5号办公楼
电话: +86-0431-85077785

长光辰芯 (杭州子公司)

地址: 浙江省杭州市滨江区建业路599号华业发展中心31层3101-3109室
电话: +86-571-87718606-888

长光辰芯 (大连子公司)

地址: 辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园7号11层#05D室
电话: +86-0411-39937666



更多联系方式